

NASA より SBIR プロジェクト、月から火星へのキャンペーンに不可欠な 放射線耐性の高耐圧 MOSFET トランジスターの開発でアワードを受賞しました。

アイスモス・テクノロジーは費用効果が高く大量生産に見合う高耐圧パワートランジスターの放射線耐性を改善する独自の立場を確立しました。

パラダイスバレー、米国アリゾナ州 2021年5月11日—アイスモス・テクノロジー社は本日、アメリカ航空宇宙局(NASA) Goddard Space Flight Center (GSFC)より、新しい耐放射線性の高電圧パワートランジスタの開発に着手するプロジェクトで受賞いたしましたことを発表いたします。パワー半導体の改善は、月から火星への長期宇宙プログラムの電源アプリケーションにおいて不可欠であり、2024年までに人類を月面に送り、10年間の持続可能な探査を確立することを目的としています。

弊社の創設者兼会長の Samuel J Anderson のコメント—

このプロジェクトは、費用効果の高い大量生産プロセスと互換性のある高電圧パワートランジスタの耐放射線性を改善することにより、宇宙船の電力システムの効率の大幅な進歩を加速するための技術開発で構成されています。厳しい条件である宇宙運用環境の信頼性要件は、独自の課題もありますが、我々の革新的なデバイス技術で対応できることを楽しみにしています。

アイスモスの本パワートランジスターはワイドバンドギャップ(WBG)の低抵抗性能を利用して、ドレインに炭化ケイ素を組み込んでいます。この開発賞は、宇宙船の電源の構成要素を可能にするための高効率、小型、高信頼性のトランジスタとして変換されるようにサイズ、重量、電力(SWaP)における技術革新を実現させることで NASA の新計画をサポートします。NASA が評価した過酷な環境での効率的な配電は、宇宙環境ではないアプリケーションにおいても、エネルギー節約に対する社会の高まる需要を満たすためにとても重要です。これらの新しい高電圧デバイスの商用アプリケーションには、クラウドコンピューティング用のデータセンターサーバーの AC / DC 電源、電気自動車用の高速バッテリー充電電源システムなどがあります。

2004年創業のアイスモス・テクノロジー社について

アイスモス・テクノロジーは費用効果が高く、高いパフォーマンスのスーパージャンクション MOSFET およびシンプルで低コストのプロセスにて競合ソリューションを凌ぐ MEMS や高度な技術基盤ウエハーでベストインクラスのサプライヤーです。北アイルランドのベルファストに製造拠点、米国アリゾナ州テンピに研究センター、日本の東京にデザインセンターがあります。詳しくは、弊社 Website へ <https://www.jp.icemostech.com>

メディアのお問合せ:

Linda Capcara

Brodeur Partners

lcapcara@brodeur.com

IceMOS のコンタクト:

Raymond Wiley(米国)

IceMOS Technology

raymondwiley@icemostech.com